

## 나노결정질 인바합금의 집합조직과 기계적 성질 Texture and Mechanical Properties of Nanocrystalline Invar Alloy

김중권, 서정호, 박용범  
순천대학교 재료·금속공학과

### 1. 서론

인바합금(Invar alloy)이라 불리는 Fe-36%Ni 조성의 합금은 열팽창계수가 0에 근접하여 열적 안정성이 뛰어나다. 열팽창 계수가 작은 재료들의 대표격인 인바합금은 표준 측정장치, 내연기관의 피스톤, 바이메탈, 온도제어장치, 액체가스 저장장치, 집적회로 리드프레임, PC/TV 모니터의 새도우마스크, 지자기 방어용 이너실드, 전기전자소자 등 매우 다양한 분야에서 응용되고 있다. 인바합금을 생산하는 기존방식은 압연법으로 진공용해로, 단조설비, 열간압연기, 다단압연기 등 대규모 설비가 필요할 뿐 아니라, 생산에 장시간이 소요되는 단점이 있다. 종래 제조방법의 한계를 극복하기 위해 최근, 전주도금에 의한 Fe-Ni 합금제조에 대한 연구가 많이 이루어지고 있다. 나노크기의 결정질로 구성된 재료는 수많은 계면을 포함하므로, 결정립계에 존재하는 원자의 부피 비율은 내부결정 영역과 관련이 있다. 이 형태적인 특징 때문에 나노결정질 재료들이 열역학적으로 비평형 상태에 있다. 그러므로 일반적인 마이크로 스케일의 결정립을 가진 재료들과 비교해서 아주 다른 성질들을 나타낸다.

### 2. 본론

본 연구에서 나노결정질 인바 합금 박판을 전주도금법으로 제조하였다. 전주도금중에 전해액의 pH는 2~3 범위로 유지하였고, 전류밀도는 50~100mA/cm<sup>2</sup>, 전해액 온도는 45~60°C로 하였다. 도금 박판의 두께는 전류밀도와 도금 시간을 변화시켜 조절하여, 전착된 인바합금의 두께는 20μm로 하였다. 전주성형방법으로 제조된 나노결정질 인바 합금의 조성은 EDS로 분석하였다. 열적인 거동을 분석하기 위해 시차열분석계를 이용하여 상온에서 450°C 까지 10°C/min의 승온속도로 가열하여 조사하였다. X-선 회절기의 Co Ka 타켓을 이용하여 극점도를 사용하여 집합조직을 측정하였다. 재료의 미세구조와 집합조직의 분석을 위해서 전계방사형 주사전자현미경에 장착된 EBSD를 사용하여 결정립들이 배향성을 관찰하였다. 전착된 도금 박판의 기계적 성질을 인장시험을 측정하였으며, 이 때 인장속도는 5min/min이었다. Nanoindentation 방법을 이용하여 재료의 경도 및 탄성계수를 측정하였다.

### 3. 결과

전착된 시편의 결정립 크기를 측정하기 위해 X-선 회절 피크를 이용한 Scherrer 식을 사용하였으며, 계산한 결정립 크기는 평균 10nm였다. 이 나노인바는 기존의 인바합금에 비해 탁월한 기계적 성질을 나타내었다. 나노재료에서는 입계를 구성하는 원자들의 비율이 높기 때문에 상대적으로 낮은 온도에서 결정성장이 일어나는데, 나노인바에서는 370°C 이상의 온도에서 결정성장이 시작한다. 전주성형된 상태에서 나노인바는 <100>//ND 집합조직이 강하게 발달되어 있고 <111>//ND 성분이 약하게 관찰되지만, 결정성장에 의해 집합조직 발달상태는 역전되어, 완전 어닐링한 시편에서는 <111>//ND 집합조직 성분이 주방위로 발달한다. 이러한 집합조직의 진화과정은 결정성장 초기에 <111>//ND 결정립들의 비정상결정성장에 의해 이루어진다는 것을 EBSD 관찰을 통해 해명하였다.

## 참고문헌

1. M.R Gallas, L. Amaral and J.M.H. da Jornada, *J. Appl. Phys.*, 70 (1991) 131.
2. N. Wang, Z. Wang, K.T. Aust and U. Erb, *Acta Mater.*, 45 (1997) 1655.
3. G. Palumbo, S.J. Thorpe and K. Aust, *Scripta Metall. Mater.*, 24 (1990) 1347.
4. C. Suryanarayana, *Int. Mater. Rev.*, 40 (1995) 41.
5. Y. B. Park, in 'Nano Invar Alloy and the Process of Producing the Same', Korea Patent No. 10-2003-0026108, (2003)
6. J. K. Kim, J. H. Seo and Y. B. Park, *Mater. Sci. Forum*, 467-470 (2004) 1313.